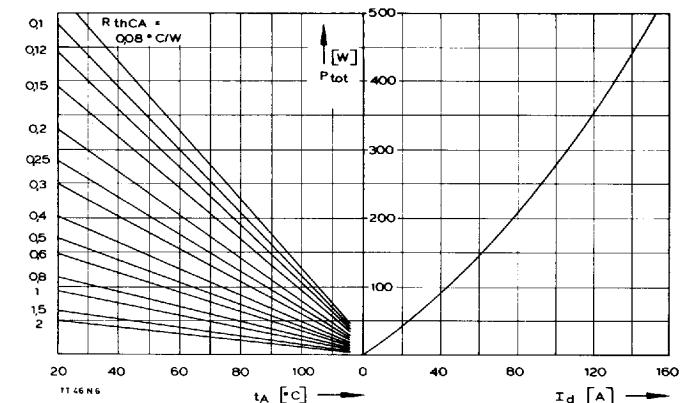
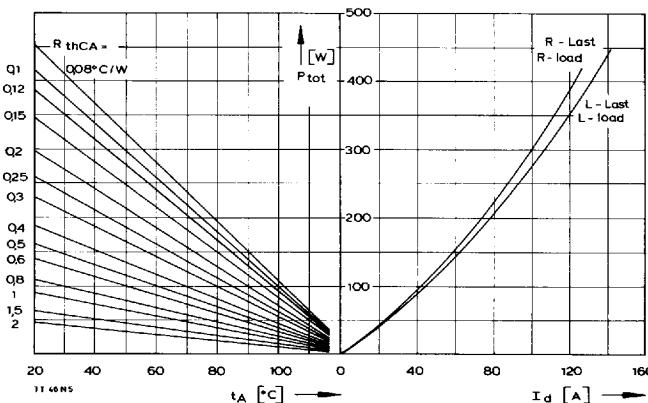
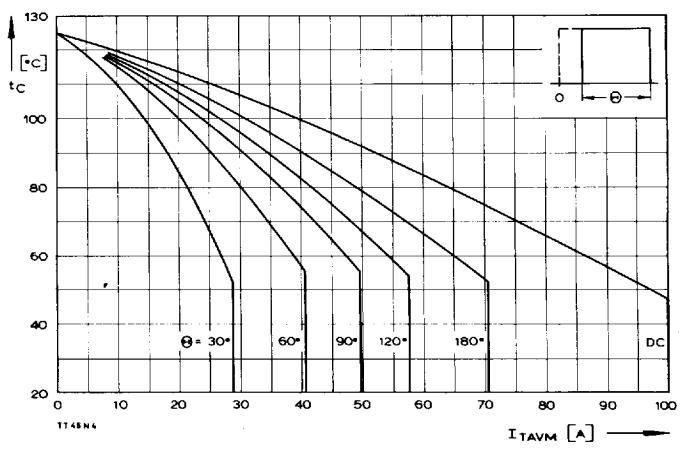
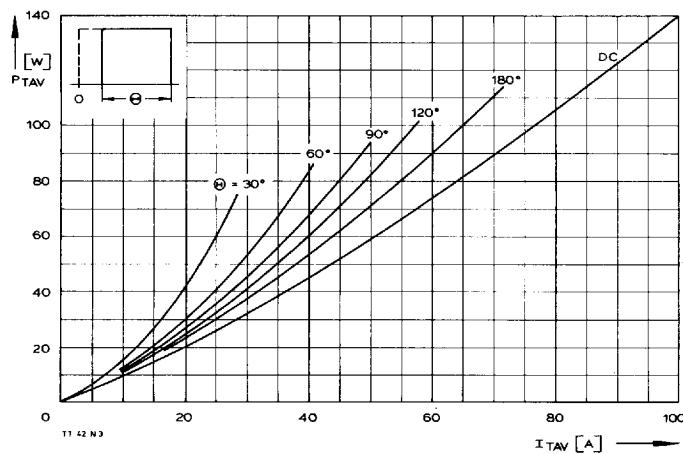
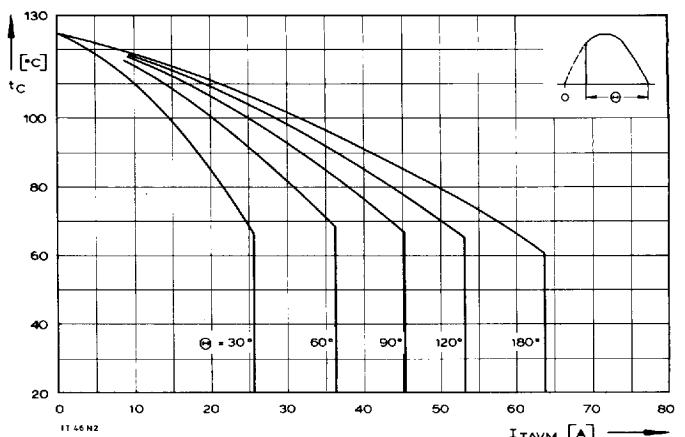
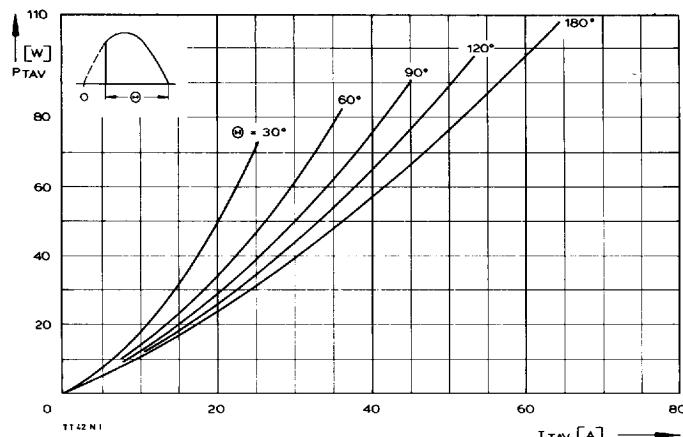


TT 46 N, TD 46 N, DT 46 N

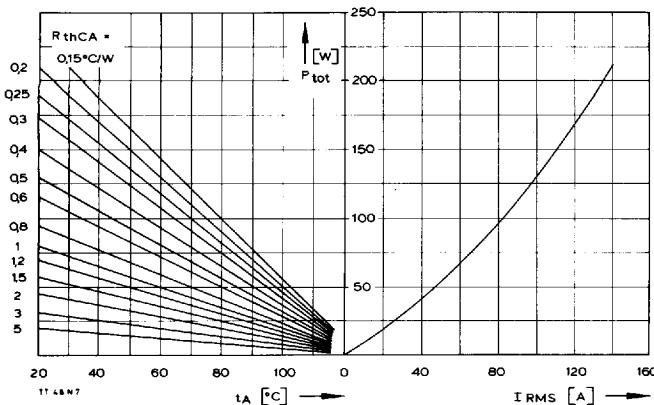
Elektrische Eigenschaften		Electrical properties			
Höchstzulässige Werte		Maximum rated values			
Periodische Vorwärts- und Rückwärts-SpitzenSperrspannung	repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj \max}$	V_{DRM}, V_{RRM}	600, 800 1000, 1200 1400, 1600	V V V
Vorwärts-StoßspitzenSpannung	non repetitive peak forward off-state voltage	$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj \max}$	$V_{DSM} = V_{DRM}$		
Rückwärts-StoßspitzenSpannung	non repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^\circ\text{C} \dots t_{vj \max}$	$V_{RSM} = V_{RRM}$	+ 100	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert	RMS on-state current	$t_C = 85^\circ\text{C}$	I_{TRMSM}	100	A
Dauergrenzstrom	average on-state current	$t_C = 61^\circ\text{C}$	I_{TAVM}	46 64	A A
Stoßstrom-Grenzwert	surge current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$ $t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$	I_{TSM}	1150 1000	A A
Grenzlastintegral	/i ² dt-value	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$ $t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$	/i ² dt	6600 5000	A ² s A ² s
Kritische Stromsteilheit	critical rate of rise of on-state current	$V_D \leq 67\% V_{DRM}, f_0 = 50 \text{ Hz}$ $V_L = 8 \text{ V}, I_{GM} = 0,6 \text{ A}, dI_G/dt = 0,6 \text{ A}/\mu\text{s}$	(di/dt) _{cr}	120	A/ μ s
Kritische Spannungssteilheit	critical rate of rise of off-state voltage	$t_{vj} = t_{vj \max}, V_D = 67\% V_{DRM}$	(dv/dt) _{cr}	1000	V/ μ s
Charakteristische Werte		Characteristic values			
Durchlaßspannung	on-state voltage	$t_{vj} = t_{vj \max}, I_T = 150 \text{ A}$	V_T	max.	1,9 V
Schleusenspannung	threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj \max}$	$V_{T(TO)}$		0,95 V
Ersatzwiderstand	slope resistance	$t_{vj} = t_{vj \max}$	r_T		4,5 m Ω
Zündstrom	gate trigger current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$	I_{GT}	max.	150 mA
Zündspannung	gate trigger voltage	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$	V_{GT}	max.	2,5 V
Nicht zündender Steuerstrom	gate non trigger current	$t_{vj} = t_{vj \max}, V_D = 6 \text{ V}$	I_{GD}	max.	5 mA
Nicht zündende Steuerspannung	gate non trigger voltage	$t_{vj} = t_{vj \max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	V_{GD}	max.	0,2 V
Haltestrom	holding current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}, R_A = 5 \Omega$	I_H	max.	200 mA
Einraststrom	latching current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}, R_{GK} \geq 20 \Omega$ $I_{GM} = 0,6 \text{ A}, dI_G/dt = 0,6 \text{ A}/\mu\text{s}, t_g = 10 \mu\text{s}$	I_L	max.	600 mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom	forward off-state and reverse currents	$t_{vj} = t_{vj \max}, V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$	i_D, i_R	max.	10 mA
Zündverzug	gate controlled delay time	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, I_{GM} = 0,6 \text{ A}, dI_G/dt = 0,6 \text{ A}/\mu\text{s}$	t_{gd}	max.	1,2 μ s
Freiwerdezeit	circuit commutated turn-off time	siehe Techn. Erl./see Techn. Inf.	t_q	typ.	60 μ s
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min	V_{ISOL}		2,5 kV
Thermische Eigenschaften		Thermal properties			
Innerer Wärmewiderstand	thermal resistance, junction to case	$\Theta = 180^\circ\text{el}, \sinus:$ pro Modul/per module pro Zweig/per arm DC: pro Modul/per module pro Zweig/per arm	R_{thJC}	max.	0,3 °C/W 0,6 °C/W 0,28°C/W 0,56°C/W
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	pro Modul/per module pro Zweig/per arm	R_{thCK}	max.	0,08°C/W 0,16°C/W
Höchstzul. Sperrschiichttemperatur	max. junction temperature	$t_{vj \max}$			125°C
Betriebstemperatur	operating temperature	$t_c \text{ op}$			- 40°C ... +125°C
Lagertemperatur	storage temperature	t_{stg}			- 40°C ... +130°C
Mechanische Eigenschaften		Mechanical properties			
Si-Elemente glaspassiviert, Lötkontakt	Si-pellets glass-passivated, soldered contact				Al_2O_3
Innere Isolation	internal insulation				
Anzugsdrehmomente	tightening torques	Toleranz/tolerance $\pm 15\%$	$M1$		4 Nm
mechanische Befestigung	mounting torque	Toleranz/tolerance + 5%/- 10%	$M2$		4 Nm
elektrische Anschlüsse	terminal connection torque		G	typ. 160 g	
Gewicht	weight	$f = 50 \text{ Hz}$		12,5 mm	
Kriechstrecke	creepage distance			5 · 9,81 m/s ²	
Schwingfestigkeit	vibration resistance			1	
Maßbild	outline				

Recognized by UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

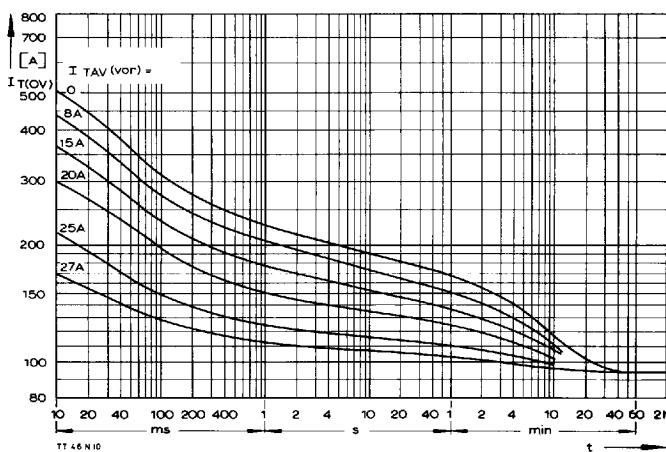
TT 46 N, TD 46 N, DT 46 N



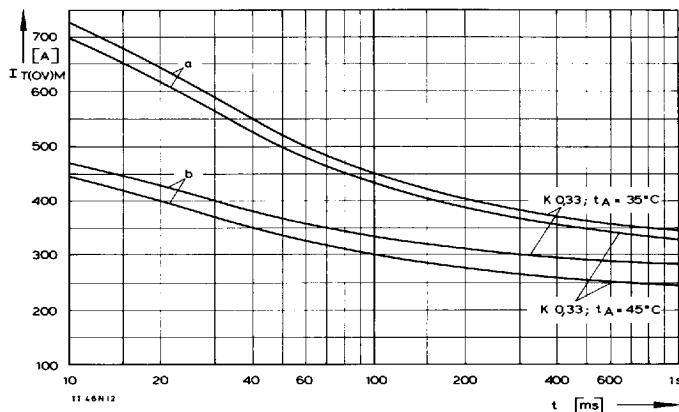
TT 46 N, TD 46 N, DT 46 N



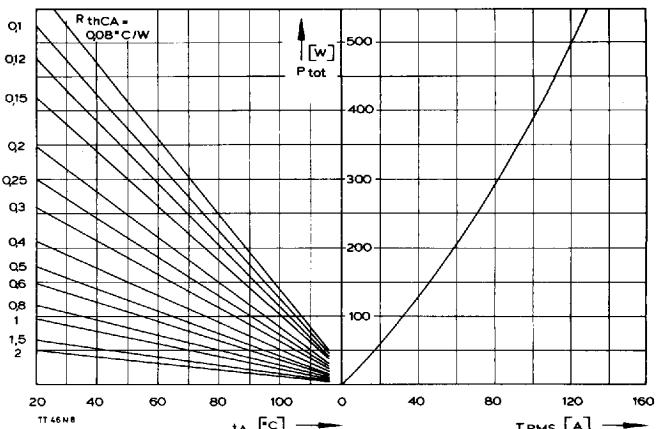
Bild/Fig. 7
W1C – Einphasen-Wechselwegschaltung/Single-phase inverse parallel circuit
Höchstzulässiger Strom I_{RMS} in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur t_A .
Maximum allowable current I_{RMS} versus ambient temperature t_A .
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}



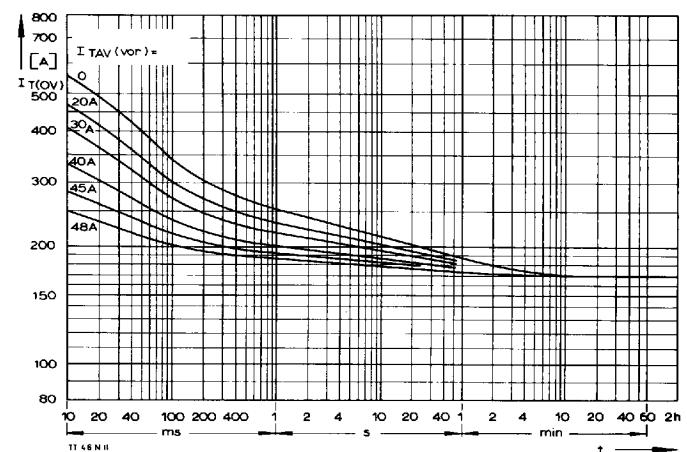
Bild/Fig. 9
B2 – Zweipuls-Brückenschaltung/Two-pulse bridge circuit
Überstrom je Zweig $I_{T(OV)}$ bei Luftselbstkühlung, $t_A = 45^\circ\text{C}$, Kühlkörper KP0,33 S.
Overload on-state current per arm $I_{T(OV)}$ at natural cooling, $t_A = 45^\circ\text{C}$,
heatsink type KP0,33 S.
Parameter: Vorlaststrom je Zweig/pre-load current per arm $I_{TAV(\text{vor})}$



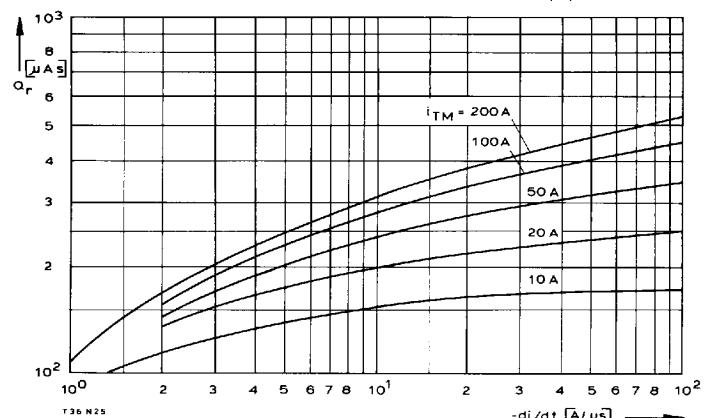
Bild/Fig. 11
Grenzstrom je Zweig $I_{T(OV)M}$ bei Luftselbstkühlung, $t_A = 45^\circ\text{C}$ und verstärkter
Luftkühlung, $t_A = 35^\circ\text{C}$, Kühlkörper KP 0,33 S, $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$.
Limiting overload on-state current per arm $I_{T(OV)M}$ at natural ($t_A = 45^\circ\text{C}$) and
forced ($t_A = 35^\circ\text{C}$) cooling, heatsink type KP 0,33 S, $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$.
a – Belastung nach Leerlauf/current surge under no-load conditions
b – Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom I_{TAVM}
Current surge occurs during operation at limiting mean on-state current
rating I_{TAVM}



Bild/Fig. 8
W3C – Dreiphasen-Wechselwegschaltung/Three-phase inverse parallel circuit
Höchstzulässiger Strom je Phase I_{RMS} in Abhängigkeit von der Umgebungs-
temperatur t_A .
Maximum allowable current per phase I_{RMS} versus ambient temperature t_A .
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

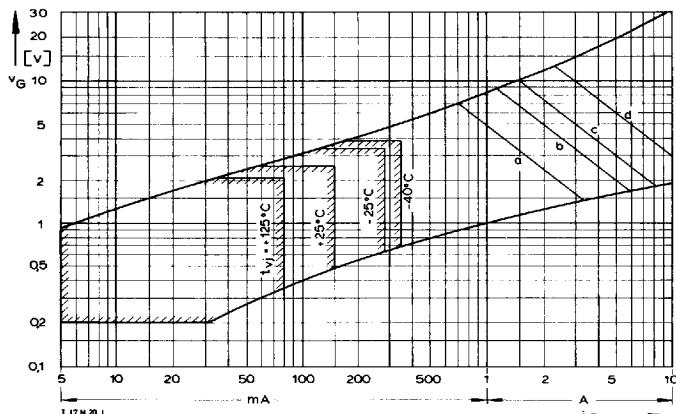


Bild/Fig. 10
B2 – Zweipuls-Brückenschaltung/Two-pulse bridge circuit
Überstrom je Zweig $I_{T(OV)}$ bei verstärkter Luftkühlung, $t_A = 35^\circ\text{C}$, $V_L = 90$ l/s,
Kühlkörper KP 0,33 S.
Overload on-state current per arm $I_{T(OV)}$ at forced cooling, $t_A = 35^\circ\text{C}$, $V_L = 90$ l/s,
heatsink type KP 0,33 S.
Parameter: Vorlaststrom je Zweig/pre-load current per arm $I_{TAV(\text{vor})}$



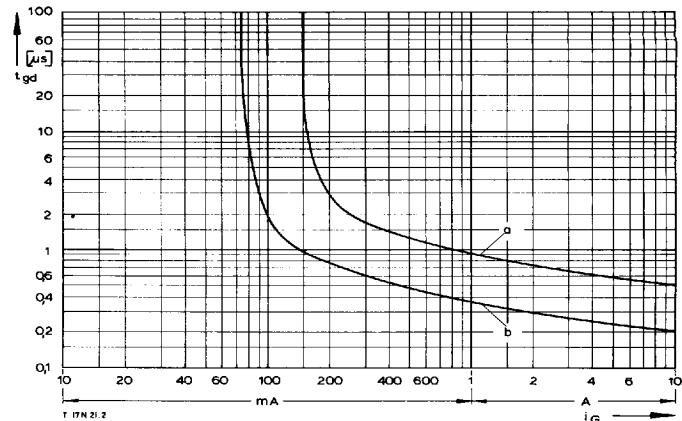
Bild/Fig. 12
Sperrverzögerungsladung Q_r in Abhängigkeit von der abkommunizierenden
Stromsteilheit $-di/dt$ bei $t_{vj} = t_{vj \max}$, $V_R = 0.5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$.
Der angegebene Verlauf ist gültig für 90% aller Elemente.
Recovered charge versus the rate of decay of the forward on-state current
 $-di/dt$ at $t_{vj} = t_{vj \max}$, $V_R = 0.5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0.8 V_{RRM}$.
These curves are valid for 90% of all devices.
Parameter: Durchlaßstrom i_{TM} /On-state current i_{TM}

TT 46 N, TD 46 N, DT 46 N

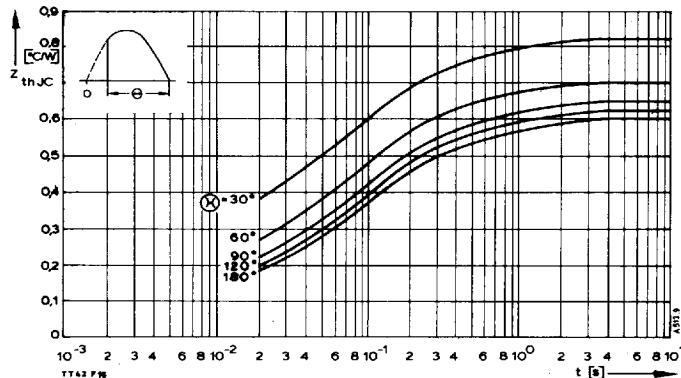


Bild/Fig. 13
Zündbereich und Spitzensteuerleistung bei $v_D = 6$ V.
Gate characteristic and peak gate power dissipation at $v_D = 6$ V.

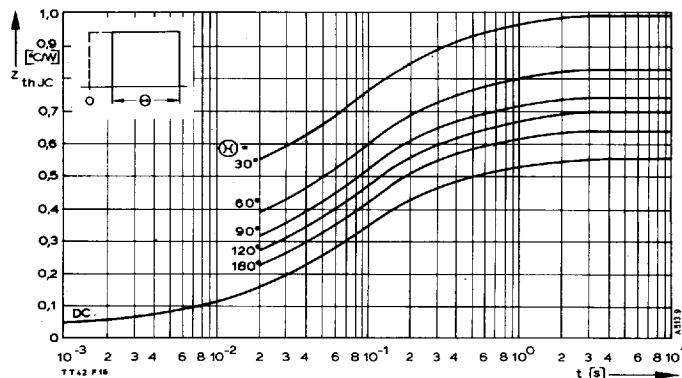
Parameter:	a	b	c	d
Steuerimpulsdauer/Pulse duration t_g [ms]	10	1	0,5	0,1
Höchstzulässige Spitzensteuerleistung/ Maximum allowable peak gate power [W]	5	10	15	30



Bild/Fig. 14
Zündverzug/Gate controlled delay time t_{gd} ,
DIN 41787, $t_s = 1 \mu\text{s}$, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$.
a – äußerster Verlauf/limiting characteristic
b – typischer Verlauf/typical characteristic



Bild/Fig. 15
Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig Z_{thJC} .
Transient thermal impedance per arm Z_{thJC} , junction to case.



Bild/Fig. 16
Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig Z_{thJC} .
Transient thermal impedance, junction to case, per arm Z_{thJC} .

Pos. n	1	2	3	4	5	6
R_{thn} [°C/W]	0,0101	0,0317	0,073	0,144	0,186	0,1152
τ_n [s]	0,000044	0,00136	0,016	0,065	0,123	0,68

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} (1 - e^{-t/\tau_n})$$

Transienter Wärmewiderstand Z_{thJC} pro Zweig für DC.
Transient thermal impedance Z_{thJC} per arm for DC.